PAT-NO:

JP02000355687A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2000355687 A

TITLE:

NOVEL AZOLE DERIVATIVE, LUMINESCENT ELEMENT

MATERIAL,

AND LUMINESCENT ELEMENT PREPARED THEREFROM

PUBN-DATE:

December 26, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

YANAGI, TERUKAZU N/A IGARASHI, TATSUYA N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

FUJI PHOTO FILM CO LTD N/A

APPL-NO: JP2000038578

APPL-DATE: February 16, 2000

PRIORITY-DATA: 11108208 (April 15, 1999)

INT-CL (IPC): C09K011/06, H05B033/14, H05B033/22, C07D213/42,

C07D215/18

, C07D231/12 , C07D235/18 , C07D241/12 , C07D249/08 ,

C07D263/56

, C07D271/06 , C07D271/10 , C07D277/66 , C07D285/125

, C07D487/04 , C07F003/06

## ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a material which gives a luminescent element

having good luminescent characteristics by using a compound having a specific

partial struc ture or a tautomer thereof or a metal complex having the compound

or tautomer as a ligand.

 ${\tt SOLUTION:}$  A compound having a partial structure represented by formula I or

a tautomer thereof or a metal complex having the compound or tautomer as a

ligand is used. In formula I, Q1 is a group of atoms necessary for forming a

nitrogen-containing aromatic 6-membered ring or a ring represented by formula

II or III; X1 to X4 are each oxygen, sulfur, optionally substituted nitrogen,

optionally substituted carbon, or selenium provided at least either  ${\tt X3}$  or  ${\tt X4}$  is

oxygen, sulfur, optionally substituted nitrogen, or selenium; Q2 is a group of

atoms necessary for forming an aromatic ring provided Q1 is not bonded to Q2 to

form an aromatic fused ring structure; and Z is SO2R1, COR2, or POR3(R4)

(wherein R1 to R4 are each an aliphatic hydrocarbon group, aryl, heterocyclic,

amino, alkoxy, aryloxy or heterocyclic oxy).

COPYRIGHT: (C) 2000, JPO

## \* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## **CLAIMS**

# [Claim(s)]

[Claim 1] The light emitting device ingredient characterized by being the compound which has the substructure expressed with the following general formula (I), or its tautomer.

$$Q_2$$
  $N$   $Z$ 

$$X_1$$
 $\longrightarrow$ 
 $N$ 

$$X_2$$
 $X_3$ 
 $X_4$ 

(Q1 expresses among a formula an atomic group required to form the ring expressed with nitrogen-containing aromatic series 6 membered-ring, a general formula (II), or a general formula (III).) X1 X2, X3, and X4 The carbon atom which is not permuted [ the nitrogen atom which is not permuted / an oxygen atom, a sulfur atom a permutation, or /, a permutation, or ] and a selenium atom are expressed. X3 X4 At least one side is the nitrogen atom which is not permuted [ an oxygen atom, a sulfur atom, a permutation, or ] and a selenium atom. Q2 An atomic group required to form an aromatic series ring is expressed. Q1 Q2 Aromatic series condensed ring structure is not taken unitedly. Z is SO two R1 and COR2. Or POR3 (R(R4) 1, R2, R3, and R4 express an aliphatic hydrocarbon radical, an aryl group, a heterocycle radical, the amino group, an alkoxy group, an aryloxy group, or a heterocycle oxy-radical, respectively.) is expressed.

[Claim 2] The light emitting device ingredient according to claim 1 characterized by being the metal complex which has in a ligand the compound which has the substructure expressed with a general formula (I), or its tautomer.

[Claim 3] The light emitting device ingredient according to claim 2 characterized by expressing a metal complex with the following general formula (K-I).

[Formula 2] 一般式 (K-I)

$$\begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{bmatrix} = N \\ N \\ Z \end{bmatrix}_m M - Ln$$

(Q1, Q2, and Z are synonymous with them of a general formula (I) among a formula.) M expresses a metal ion. m expresses the integer of 1-3. L expresses a ligand. n -- m+n= -- the integer used as 2 or 3 is expressed.

[Claim 4] The light emitting device ingredient according to claim 3 characterized by M being a divalent

or trivalent metal ion.

[Claim 5] The compound which has the substructure expressed with the following general formula (IV), or its tautomer.

(R1 expresses an aliphatic hydrocarbon radical, an aryl group, a heterocycle radical, the amino group, an alkoxy group, an aryloxy group, or a heterocycle oxy-radical among a formula.) Rd1, Rd2, Rd3, Rd4, Rd5, Rd8, and Rd10 A hydrogen atom or a substituent is expressed, respectively. Y is an oxygen atom, a sulfur atom, N-R (R expresses a substituent.), and CH2. Or the permuted carbon atom or a selenium atom is expressed. Q3 An atomic group required to form a ring is expressed.

[Claim 6] The metal complex which has in a ligand the compound which has the substructure expressed with said general formula (IV), or its tautomer.

[Claim 7] The light emitting device ingredient characterized by being the metal complex which has in a ligand the compound which has the substructure expressed with said general formula (IV), or its tautomer.

[Claim 8] The metal complex expressed with the following general formula (K-IV).

(R1 expresses an aliphatic hydrocarbon radical, an aryl group, a heterocycle radical, the amino group, an alkoxy group, an aryloxy group, or a heterocycle oxy-radical among a formula.) Rd1, Rd2, Rd3, Rd4, Rd5, and Rd8 express a hydrogen atom or a substituent, respectively. X5 The nitrogen atom which is not permuted [ a \*\*\*\*\*\* atom, a sulfur atom, a permutation, or ] and CH2 Or the permuted carbon atom or a selenium atom is expressed. Q3 An atomic group required to form a ring is expressed. M expresses a metal ion. m expresses the integer of 1-3.

[Claim 9] The light emitting device ingredient characterized by being the metal complex expressed with a general formula (K-IV).

[Claim 10] The compound which has the substructure expressed with the following general formula (V), or its tautomer.

[Formula 5]

(Rd1, Rd2, Rd3, Rd4, Rd5, Rd6, Rd7, Rd8, Rd10, and Rd21, Rd22, Rd23 and Rd24 express a hydrogen atom or a substituent among a formula, respectively.) X5 The nitrogen atom which is not permuted [ a \*\*\*\*\*\* atom, a sulfur atom, a permutation, or ] and CH2 Or the permuted carbon atom or a selenium atom is expressed.

[Claim 11] The metal complex which has in a ligand the compound which has the substructure expressed with a general formula (V), or its tautomer.

[Claim 12] The light emitting device ingredient characterized by being the metal complex which has in a ligand the compound which has the substructure expressed with a general formula (V), or its tautomer. [Claim 13] The metal complex expressed with the following general formula (K-V). [Formula 6]

一般式 (K-V)

(Rd1, Rd2, Rd3, Rd4, Rd5, Rd6, Rd7, Rd8, Rd21, Rd22 and Rd23, and Rd24 express a hydrogen atom or a substituent among a formula, respectively.) X5 The nitrogen atom which is not permuted [ a \*\*\*\*\*\* atom, a sulfur atom, a permutation, or ] and CH2 Or the permuted carbon atom or a selenium atom is expressed. M expresses a metal ion. m expresses the integer of 1-3.

[Claim 14] The light emitting device ingredient characterized by being the metal complex expressed with a general formula (K-V).

[Claim 15] The light emitting device characterized by being the layer in which at least one layer contains a compound or a light emitting device ingredient given [ any / one ] in claim 1-14 in the light emitting device in which two or more organic compound thin layers which contain a luminous layer or a luminous layer in inter-electrode [ of a pair ] were formed.

[Claim 16] The light emitting device characterized by being the layer to which at least one layer distributed the compound or light emitting device ingredient of any one publication of claim 1-14 to the polymer in the light emitting device in which two or more organic compound thin layers which contain a luminous layer or a luminous layer in inter-electrode [ of a pair ] were formed.

[Claim 17] The light emitting device characterized by being the layer in which the above-mentioned luminous layer contains a compound or a light emitting device ingredient given [ any / one ] in claim 1-14 in the light emitting device in which two or more organic compound thin layers which contain a luminous layer or a luminous layer in inter-electrode [ of a pair ] were formed. [Claim 18] The light emitting device characterized by being the layer in which at least one layer between a luminous layer and cathode contains a compound or a light emitting device ingredient given [ any / one ] in claim 1-14 in the light emitting device in which two or more organic compound thin layers which contain a luminous layer or a luminous layer in inter-electrode [ of a pair ] were formed.

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-355687 (P2000-355687A)

(43)公開日 平成12年12月26日(2000.12.26)

(51) Int.CL.	識別記号	FΙ	テーマコード( <del>参考</del> )
C09K 11/06	660	C 0 9 K 11/06	660
H05B 33/14	•	H 0 5 B 33/14	В
33/22		33/22	В
// C 0 7 D 213/42		C 0 7 D 213/42	
215/18		215/18	
	審査請求	未請求 請求項の数1	8 OL (全 31 頁) 最終頁に続く
(21)出顧番号	特顧2000-38578( P2000-38578)	(71)出顧人 00000	05201
		富士	写真フイルム株式会社
(22)出顧日	平成12年2月16日(2000.2.16)	神奈	川県南足柄市中沼210番地
		(72)発明者 柳	<b>坪</b>
(31)優先権主張番号	特顧平11-108208	神奈	川県南足柄市中沼210番地 富士写真
(32)優先日	平成11年4月15日(1999.4.15)	フイ	ルム株式会社内
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者 五十	<b>美達也</b>
		神奈	川県南足柄市中沼210番地 富士写真
		フイ	ルム株式会社内
	·	(74)代理人 10007	<sup>7</sup> 3874

# (54) 【発明の名称】 新規アゾール誘導体、発光素子材料およびそれを使用した発光素子

#### (57)【要約】

【課題】高輝度、高効率の発光が可能な発光素子材料及 びそれを使用した発光素子を提供する。

【解決手段】下記一般式(I)で表される部分構造を有

一般式 (II) 一般式 (I)

する化合物からなる発光素子材料及びそれを使用した発 光素子。

【化1】







一般式(III)

式中、Q1 は含窒素芳香族6員環、一般式 (II) 又は(I II) で表される環を形成するに必要な原子群を表す。X 1 ~X4 はO、S、置換又は無置換の窒素原子、置換又 は無置換の炭素原子、Seを表す。X3、X4の少なく とも一方は〇、S、置換又は無置換の窒素原子、Seで ある。Q2 は芳香族環を形成するに必要な原子群を表

す。Q1 とQ2 が結合して芳香族縮環構造を取ることは ない。Zは、SO2 R1、COR2 又はPOR3 (R4) (R1 、R2 、R3 及びR4 は各々脂肪族炭化水素基、 アリール基、ヘテロ環基、アミノ基、アルコキシ基、ア リールオキシ基又はヘテロ環オキシ基を表す。)を表 す。

【特許請求の範囲】

\*する発光素子材料。

【化1】

【請求項1】 下記一般式(I)で表される部分構造を

有する化合物またはその互変異性体であることを特徴と\*

一般式 (I)

一般式(II)

一般式(III)





(式中、Q1 は含窒素芳香族6員環、一般式(II)または一般式(III)で表される環を形成するに必要な原子群を表す。X1、X2、X3、X4は酸素原子、硫黄原子、置換または無置換の炭素原子、七レン原子を表す。X3、X4の少なくとも一方は酸素原子、硫黄原子、置換または無置換の炭素原子、セレン原子である。Q2は芳香族環を形成するに必要な原子群を表す。Q1とQ2が結合して芳香族縮環構造を取ることはない。Zは、SO2R1、COR2またはPOR3(R4)(R1、R2、R3およびR4は20それぞれ脂肪族炭化水素基、アリール基、ヘテロ環基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基またはヘテロ環オキシ基を表す。)を表す。)

【請求項2】 一般式(I)で表される部分構造を有する化合物またはその互変異性体を配位子に有する金属錯体であることを特徴とする請求項1に記載の発光素子材料。

【請求項3】 金属錯体が下記一般式(K-I)で表されることを特徴とする請求項2記載の発光素子材料。

【化2】 一般式 (K-I)

Q<sub>2</sub> N Z m

(式中、 $Q_1$ 、 $Q_2$ 、及びZは一般式(I)のそれらと 同義である。Mは金属イオンを表す。mは $1\sim3$ の整数 を表す。Lは配位子を表す。nはm+n=2または3と なる整数を表す。)

【請求項4】 Mが2価または3価の金属イオンである※

一般式(K-IV)

※ことを特徴とする請求項3に記載の発光素子材料。

【請求項5】 下記一般式 (IV) で表される部分構造 またはその互変異性体を有する化合物。

【化3】

R<sub>d4</sub> R<sub>d3</sub> R<sub>d2</sub> R<sub>d2</sub> R<sub>d2</sub> R<sub>d1</sub> R<sub>d2</sub> R<sub>d2</sub> R<sub>d1</sub> R<sub>d2</sub> R<sub>d1</sub> R<sub>d2</sub> R<sub>d2</sub> R<sub>d3</sub> R<sub>d1</sub> R<sub>d2</sub> R<sub>d3</sub> R<sub>d1</sub> R<sub>d2</sub> R<sub>d3</sub> R<sub>d3</sub>

(式中、 $R_1$  は脂肪族炭化水素基、アリール基、ヘテロ環基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、またはヘテロ環オキシ基を表す。 $R_{d1}$ 、 $R_{d2}$ 、 $R_{d3}$ 、 $R_{d4}$ 、 $R_{d5}$ 、 $R_{d8}$ 、および $R_{d10}$  はそれぞれ水素原子または置換基を表す。Yは酸素原子、硫黄原子、N—R(Rは置換基を表す。)、 $CH_2$  もしくは置換された炭

30 素原子、またはセレン原子を表す。Q3 は環を形成するのに必要な原子群を表す。)

【請求項6】 前記一般式 (IV)で表される部分構造を有する化合物またはその互変異性体を配位子に有する金属錯体。

【請求項7】 前記一般式 (IV) で表される部分構造 を有する化合物またはその互変異性体を配位子に有する 金属錯体であることを特徴とする発光素子材料。

【請求項8】 下記一般式 (K-IV) で表される金属 錯体。

40 【化4】

R<sub>d4</sub> R<sub>d3</sub>
R<sub>d2</sub>
R<sub>d5</sub> N R<sub>d1</sub>
R<sub>d8</sub> R<sub>1</sub>

(式中、R1 は脂肪族炭化水素基、アリール基、ヘテロ環基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、またはヘテロ環オキシ基を表す。Rd1、Rd2、Rd3、Rd4、Rd5、およびRd8はそれぞれ水素原子または置換基を表す。X5 は酸素原子、硫黄原子、置換もしくは無置換の窒素原子、CH2 もしくは置換された炭素原子、またはセレン原子を表す。Q3 は環を形成するのに必要\*
―般式 (V)

\*な原子群を表す。Mは金属イオンを表す。mは1~3の 整数を表す。)

【請求項9】 一般式 (K-IV)で表される金属錯体であることを特徴とする発光素子材料。

【請求項10】 下記一般式(V)で表される部分構造 またはその互変異性体を有する化合物。

(式中、Rd1、Rd2、Rd3、Rd4、Rd5、Rd6、Rd7、 Rd8、Rd10 、Rd21、Rd22、Rd23、Rd24はそれ ぞれ水素原子または置換基を表す。X5 は酸素原子、硫 黄原子、置換もしくは無置換の窒素原子、CH2 もしく は置換された炭素原子、またはセレン原子を表す。)

【請求項11】 一般式 (V) で表される部分構造を有する化合物またはその互変異性体を配位子に有する金属※ 一般式 (K-V) ※錯体。

20 【請求項12】 一般式(V)で表される部分構造を有 する化合物またはその互変異性体を配位子に有する金属 錯体であることを特徴とする発光素子材料。

【請求項13】 下記一般式 (K-V) で表される金属 錯体。

【化6】

(式中、R<sub>d1</sub>、R<sub>d2</sub>、R<sub>d3</sub>、R<sub>d4</sub>、R<sub>d5</sub>、R<sub>d6</sub>、R<sub>d7</sub>、R<sub>d8</sub>、R<sub>d21</sub>、R<sub>d22</sub>、R<sub>d23</sub> およびR<sub>d24</sub> はそれぞれ 水素原子または置換基を表す。X<sub>5</sub> は酸素原子、硫黄原子、置換もしくは無置換の窒素原子、CH<sub>2</sub> もしくは置換された炭素原子、またはセレン原子を表す。Mは金属イオンを表す。mは1~3の整数を表す。)

【請求項14】 一般式 (K-V) で表される金属錯体 であることを特徴とする発光素子材料。

【請求項15】 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合物薄層を形成した発光素子において、少なくとも一層が請求項1~14のいずれか1つに記載の化合物または発光素子材料を含有する層であるこ★50

★とを特徴とする発光素子。

ご請求項16】 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合物薄層を形成した発光素子において、少なくとも一層が請求項1~14のいずれか1つに記載の化合物または発光素子材料をボリマーに分散した層であることを特徴とする発光素子。

【請求項17】 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合物薄層を形成した発光素子において、上記発光層が請求項1~14のいずれか1つに記載の化合物または発光素子材料を含有する層であることを特徴とする発光案子。

【請求項18】 一対の電極間に発光層もしくは発光層

を含む複数の有機化合物薄層を形成した発光素子におい て、発光層と陰極との間の少なくとも一層が請求項1~ 14のいずれか1つに記載の化合物または発光素子材料 を含有する層であることを特徴とする発光素子。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気エネルギーを 光に変換して発光できる化合物(発光素子用材料)およ び発光素子に関し、表示素子、ディスプレイ、バックラ イト、電子写真、照明光源、記録光源、読み取り光源、 標識、看板、インテリア等の分野に好適に使用できる発 光素子に関する。

### [0002]

【従来の技術】今日、種々の表示素子に関する研究開発 が活発であり、中でも有機電界発光 (EL)素子は、低 電圧で高輝度の発光を得ることができるため、有望な表 示素子として注目されている。例えば、有機化合物の蒸 着により有機薄膜を形成する発光素子が知られている (アプライド フィジックス レターズ, 51巻, 91 3頁、1987年)。この文献に記載された発光素子は 20 トリス (8-ヒドロキシキノリナト) アルミニウム錯体 (Alq)を電子輸送材料として用い、正孔輸送材料 (アミン化合物)と積層させることにより、従来の単層 型素子に比べて発光特性を大幅に向上させている。

【0003】上記稽層型発光素子の発光効率を更に改良 する手段として、蛍光色素をドープする方法が知られて いる。例えば、ジャーナル オブ アプライド フィジ ックス 65巻、3610頁、1989年に記載のクマ リン色素をドープした発光素子はドープしない素子に比 蛍光性化合物の種類を変えることにより所望の波長の光 を取り出すことが可能であるが、電子輸送材料としてA 1 qを用いた場合、高輝度を得るために駆動電圧を高く すると、ドープした蛍光性化合物の発光の他にAlqの\* \*緑色発光が観測されてくるため、青色や赤色発光させる 場合には色純度の低下が問題になり、色純度を低下させ ないホスト材料の開発が望まれている。

【0004】また、これまで開発されてきた発光素子 は、素子構成、材料の改善等により、発光強度、耐久性 等が改良されてきているものの、様々な用途展開を考え た場合、未だ十分な性能を有していない。例えば、A1 qなどの従来の金属錯体は、電界発光時に化学的に不安 定であり、また陰極との密着も悪く、素子劣化の問題も 解決されていない。さらにAlqの場合、オキシンを配 10 位子に用いた錯体であり、その素材安全性も懸念されて おり、安全性上問題のない発光素子用の電子輸送材料の 開発が求められている。

【0005】一方、有機発光素子において高輝度発光を 実現しているものは有機物質を真空蒸着によって積層し ている素子であるが、製造工程の簡略化、加工性、大面 積化等の観点から塗布方式による素子作製が望ましい。 しかしながら、従来の塗布方式で作製した素子では発光 輝度、発光効率の点で蒸着方式で作製した素子に劣って おり、高輝度、高効率発光化が大きな課題となってい た。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、発光 特性が良好な発光素子およびそれを可能にする発光素子 用材料の提供にある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】この課題は下記手段によ って達成された。

【0008】 [1] 下記一般式 (I) で表される部分構 べて発光効率が大幅に向上している。この場合、用いる 30 造を有する化合物またはその互変異性体であることを特 徴とする発光素子材料。

[0009]

【化7】

一般式(III) 一般式(II) 一般式(1)







【0010】(式中、Q1は含窒素芳香族6員環、一般 式(II)または一般式(III)で表される環を形成 するに必要な原子群を表す。X1 、X2 、X3 、X4 は 酸素原子、硫黄原子、置換または無置換の窒素原子、置 換または無置換の炭素原子、セレン原子を表す。X3 、 X4 の少なくとも一方は酸素原子、硫黄原子、置換また は無置換の窒素原子、セレン原子である。Qz は芳香族 環を形成するに必要な原子群を表す。Q1 とQ2 が結合 して芳香族縮環構造を取ることはない。Zは、SO2 R※50 を特徴とする〔2〕記載の発光素子材料。

※1、COR2 またはPOR3 (R4)(R1、R2、R3 およびRaはそれぞれ脂肪族炭化水素基、アリール基、 ヘテロ環基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ 基またはヘテロ環オキシ基を表す。)を表す。)

[2] 一般式(I)で表される部分構造を有する化合物 またはその互変異性体を配位子に有する金属錯体である ことを特徴とする〔1〕に記載の発光素子材料。

〔3〕金属錯体が下記一般式(K-I)で表されること

【0011】 【化8】 一般式 (K-I)

$$\begin{bmatrix} Q_1 & & & \\ & & & \\ Q_2 & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & &$$

【0012】(式中、Q1、Q2、及びZは一般式 (I)のそれらと同義である。Mは金属イオンを表す。 mは1~3の整数を表す。Lは配位子を表す。nはm+ n=2または3となる整数を表す。)

- 〔4〕Mが2価または3価の金属イオンであることを特徴とする〔3〕記載の発光素子材料。
- (5)下記一般式 (IV) で表される部分構造またはその互変異性体を有する化合物。

[0013]

【化9】

一般式 (IV)

 $\begin{array}{c|c}
R_{d4} & R_{d3} \\
\hline
R_{d5} & R_{d1} \\
\hline
R_{d10} & SO_2
\end{array}$ 

\* Ra4 Ra3 Ra2 Ra5 N Ra1 M

\*【0014】(或中、R1 は脂肪族炭化水素基、アリール基、ヘテロ環基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、またはヘテロ環オキシ基を表す。Rd1、Rd2、Rd3、Rd4、Rd5、Rd8、およびRd10 はそれぞれ水素原子または置換基を表す。Yは酸素原子、硫黄原子、N-R(Rは置換基を表す。)、CH2もしくは置換された炭素原子、セレン原子を表す。Q3 は環を形成するのに必要な原子群を表す。)

- [6]一般式(IV)で表される部分構造を有する化合 10 物またはその互変異性体を配位子に有する金属錯体。
  - 〔7〕一般式 (IV) で表される部分構造を有する化合物またはその互変異性体を配位子に有する金属錯体であることを特徴とする発光素子材料。
  - (8)下記一般式 (K-IV)で表される金属錯体。【0015】【化10】

※3の整数を表す。)

- 〔9〕一般式(K-IV)で表される金属錯体であることを特徴とする発光素子材料。
- 〔10〕下記一般式 (V)で表される部分構造またはそ の互変異性体を有する化合物。

[0017]

【化11】

7

般式(V)

Ras

【0018】(式中、Rd1、Rd2、Rd3、Rd4、Rd5、 Rd6, Rd7, Rd8, Rd10, Rd21, Rd22, Rd23 B よびRd24 はそれぞれ水素原子または置換基を表す。X 5 は酸素原子、硫黄原子、置換または無置換の窒素原 子、CH2もしくは置換された炭素原子、セレン原子を 表す。)

[11]一般式(V)で表される部分構造を有する化合\* **一般式(K-V)** 

\*物またはその互変異性体を配位子に有する金属錯体。

[12]一般式(V)で表される部分構造を有する化合 物またはその互変異性体を配位子に有する金属錯体であ ることを特徴とする発光素子材料。

10

[13]下記一般式 (K-V)で表される金属錯体。

[0019]

【化12】

【0020】(式中、Rd1、Rd2、Rd3、Rd4、Rd5、 Rd6, Rd7, Rd8, Rd21, Rd22, Rd23 BLUR d24 はそれぞれ水素原子または置換基を表す。X5 は酸 素原子、硫黄原子、置換または無置換の窒素原子、CH 2もしくは置換された炭素原子、セレン原子を表す。M は金属イオンを表す。mは1~3の整数を表す。)

〔14〕一般式 (K-V) で表される金属錯体であるこ とを特徴とする発光素子材料。

〔15〕一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複 40 数の有機化合物薄層を形成した発光素子において、少な くとも一層が〔1〕~〔14〕のいずれか1つに記載の 化合物または発光素子材料を含有する層であることを特 徴とする発光素子。

〔16〕一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複 数の有機化合物薄層を形成した発光素子において、少な くとも一層が〔1〕~〔14〕のいずれか1つに記載の 化合物または発光素子材料をポリマーに分散した層であ ることを特徴とする発光素子。

※数の有機化合物薄層を形成した発光素子において、上記 発光層が〔1〕~〔14〕のいずれか1つに記載化合物 またはの発光素子材料を含有する層であることを特徴と する発光素子。

[18] 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複 数の有機化合物薄層を形成した発光素子において、発光 層と陰極との間の少なくとも一層が〔1〕~〔14〕の いずれか1つに記載の化合物または発光素子材料を含有 する層であることを特徴とする発光素子。

## [0021]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。まず、一般式 ( I ) で表される部分構造を有する 化合物について説明する。Q1 は含窒素芳香族6員環、 一般式(II)で表される環、または、一般式(II I)で表される環を形成するに必要な原子群を表す。X 1 、X2 、X3 、X4は酸素原子、硫黄原子、置換また は無置換の窒素原子、置換または無置換の炭素原子、セ レン原子を表す。X3 、X4 の少なくとも一方は酸素原 〔17〕一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複※50 子、硫黄原子、置換または無置換の窒素原子、セレン原 子である。X2 、X3 、X4 上の置換基同士が結合し、 縮合環を形成しても良い。Q1 とQ2 が結合して芳香族 縮環構造を取ることはない。

【0022】Q1 で形成される含窒素ヘテロ環は、好ま しくは炭素数2~30、より好ましくは炭素数3~2 0、さらに好ましくは炭素数3~15、特に好ましくは 炭素数4~10である。Q1 で形成される含窒素芳香族 6員環としては、例えばピリジン、キノリン、ピラジ ン、ピリダジン、イソキノリン、キノキサリンなどが挙 りより好ましくはピリジン、ピラジンであり、さらに好 ましくは、ピリジンである。一般式(II)で表される 環としては、例えばベンゾオキサゾール、ベンゾイミダ ゾール、ベンゾチアゾール、インドレニンが挙げられ、 好ましくは、ベンゾオキサゾール、ベンゾイミダゾール であり、より好ましくはベンゾオキサゾールである。一 **般式(III)で表される環としては、例えばピラゾー** ル、オキサジアゾール、ピラゾロトリアゾール、イソオ キサゾール、トリアゾール、チアジアゾール、ピロロト リアゾール、イミダゾトリアゾールなどが挙げられ、好 20 ましくは、オキサジアゾール、トリアゾール、ピラゾロ トリアゾール、ピロロトリアゾール、チアジアゾールで あり、より好ましくは、オキサジアゾール、トリアゾー ルであり、さらに好ましくはオキサジアゾールである。 【0023】Q1 で形成される含窒素ヘテロ環は好まし くは一般式(II)または一般式(III)で表される ヘテロ環であり、より好ましくは、一般式(II)で表 されるヘテロ環である。

【0024】Q2 は芳香族環を形成するに必要な原子群 を表す。Q1 とQ2 が結合して芳香族縮環構造を取るこ 30 とはない。Q2 で形成される芳香族環は芳香族炭化水素 環、芳香族へテロ環のいずれでもよく、例えばベンゼ ン、ナフタレン、ピロール、イミダゾール、ピラゾー ル、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、チ アゾール、イソチアゾール、オキサゾール、イソオキサ ゾール、セレナゾール、トリアジンなどが挙げられ、好 ましくはベンゼン、ナフタレン、ピリジン、ピラジン、 ピリミジン、ピリダジンであり、より好ましくはベンゼ ン、ナフタレン、ピリジンであり、更に好ましくはベン ゼン、ナフタレンである。

【0025】Q1 で形成される環、Q2 で形成される芳 香族環は、置換基を有してもよく、置換基としては例え ばアルキル基 (好ましくは炭素数1~30、より好まし くは炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~10で あり、例えばメチル、エチル、iso-プロピル、te rtーブチル、nーオクチル、nーデシル、nーヘキサ デシル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキ シルなどが挙げられる。)、アルケニル基(好ましくは 炭素数2~30、より好ましくは炭素数2~20、特に 好ましくは炭素数2~10であり、例えばビニル、アリ 50 る。)、スルホニルアミノ基(好ましくは炭素数1~3

12 ル、2-ブテニル、3-ペンテニルなどが挙げられ る。)、アルキニル基(好ましくは炭素数2~30、よ り好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2 ~10であり、例えばプロパルギル、3-ペンチニルな どが挙げられる。)、アリール基(好ましくは炭素数6 ~30、より好ましくは炭素数6~20、特に好ましく は炭素数6~12であり、例えばフェニル、p-メチル フェニル、ナフチル、アントラニルなどが挙げられ る。)、アミノ基(好ましくは炭素数0~30、より好 げられ、好ましくはピリジン、キノリン、ピラジンであ 10 ましくは炭素数 $0\sim20$ 、特に好ましくは炭素数 $0\sim1$ 0であり、例えばアミノ、メチルアミノ、ジメチルアミ ノ、ジエチルアミノ、ジベンジルアミノ、ジフェニルア ミノ、ジトリルアミノなどが挙げられる。)、アルコキ シ基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素 数1~20、特に好ましくは炭素数1~10であり、例 えばメトキシ、エトキシ、ブトキシ、2-エチルヘキシ ロキシなどが挙げられる。)、アリールオキシ基(好ま しくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~2 0、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェ ニルオキシ、1ーナフチルオキシ、2ーナフチルオキシ などが挙げられる。)、ヘテロアリールオキシ基(好ま しくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばピリ ジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリミジルオキシ、キノ リルオキシなどが挙げられる。)、アシル基(好ましく は炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特 に好ましくは炭素数1~12であり、例えばアセチル、 ベンゾイル、ホルミル、ピバロイルなどが挙げられ る。)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数2 ~30、より好ましくは炭素数2~20、特に好ましく は炭素数2~12であり、例えばメトキシカルボニル、 エトキシカルボニルなどが挙げられる。)、アリールオ キシカルボニル基 (好ましくは炭素数7~30、より好 ましくは炭素数7~20、特に好ましくは炭素数7~1 2であり、例えばフェニルオキシカルボニルなどが挙げ られる。)、アシルオキシ基(好ましくは炭素数2~3 0、より好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭 素数2~10であり、例えばアセトキシ、ベンゾイルオ キシなどが挙げられる。)、アシルアミノ基(好ましく は炭素数2~30、より好ましくは炭素数2~20、特 に好ましくは炭素数2~10であり、例えばアセチルア ミノ、ベンゾイルアミノなどが挙げられる。)、アルコ キシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数2~30、 より好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数 2~12であり、例えばメトキシカルボニルアミノなど が挙げられる。)、アリールオキシカルボニルアミノ基 (好ましくは炭素数7~30、より好ましくは炭素数7 ~20、特に好ましくは炭素数7~12であり、例えば フェニルオキシカルボニルアミノなどが挙げられ

0、より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭 素数1~12であり、例えばメタンスルホニルアミノ、 ベンゼンスルホニルアミノなどが挙げられる。)、スル ファモイル基 (好ましくは炭素数0~30、より好まし くは炭素数0~20、特に好ましくは炭素数0~12で あり、例えばスルファモイル、メチルスルファモイル、 ジメチルスルファモイル、フェニルスルファモイルなど が挙げられる。)、カルバモイル基(好ましくは炭素数 1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好まし くは炭素数1~12であり、例えばカルバモイル、メチ ルカルバモイル、ジエチルカルバモイル、フェニルカル バモイルなどが挙げられる。)、アルキルチオ基(好ま しくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメチ ルチオ、エチルチオなどが挙げられる。)、アリールチ オ基(好ましくは炭素数6~30、より好ましくは炭素 数6~20、特に好ましくは炭素数6~12であり、例 えばフェニルチオなどが挙げられる。)、ヘテロアリー ルチオ基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは 炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~12であ り、例えばピリジルチオ、2-ベンズイミダゾリルチ オ、2-ベンズオキサゾリルチオ、2-ベンズチアゾリ ルチオなどが挙げられる。)、スルホニル基(好ましく は炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特 に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメシル、ト シルなどが挙げられる。)、スルフィニル基(好ましく は炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特 に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメタンスル フィニル、ベンゼンスルフィニルなどが挙げられ る。) 、ウレイド基 (好ましくは炭素数 1~30、より 30 ~8であり、例えばビニル、アリル、2-ブテニル、3 好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~ 12であり、例えばウレイド、メチルウレイド、フェニ ルウレイドなどが挙げられる。)、リン酸アミド基(好 ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばジエ チルリン酸アミド、フェニルリン酸アミドなどが挙げら れる。)、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原子 (例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原 子)、シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニトロ 基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、 イミノ基、ヘテロ環基 (好ましくは炭素数1~30、よ り好ましくは炭素数1~12であり、ヘテロ原子として は、例えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子、具体的には 例えばイミダゾリル、ピリジル、キノリル、フリル、チ エニル、ピペリジル、モルホリノ、ベンズオキサゾリ ル、ベンズイミダゾリル、ベンズチアゾリルなどが挙げ られる。)、シリル基(好ましくは炭素数3~40、よ り好ましくは炭素数3~30、特に好ましくは炭素数3 ~24であり、例えばトリメチルシリル、トリフェニル

の置換基は更に置換されてもよい。また置換基が二つ以 上ある場合は、同じでも異なってもよい。

【0026】置換基として好ましくは、アルキル基、ア ルケニル基、アルキニル基、アリール基、アミノ基、ア ルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、アルコキシ カルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシルオ キシ基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ 基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルホニルア ミノ基、スルファモイル基、カルバモイル基、アルキル チオ基、アリールチオ基、スルホニル基、ハロゲン原 子、シアノ基、ヘテロ環基であり、より好ましくはアル キル基、アルケニル基、アリール基、ハロゲン原子、シ アノ基、ヘテロ環基であり、更に好ましくはアルキル 基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基であり、特 に好ましくはアルキル基、アルケニル基、アリール基、 芳香族ヘテロ環基である。

【0027】Zは、SO2 R1、COR2 またはPOR 3 (R<sub>4</sub>) (R<sub>1</sub> 、R<sub>2</sub> 、R<sub>3</sub> 、R<sub>4</sub>はそれぞれ脂肪族炭 化水素基、アリール基、ヘテロ環基、アミノ基、アルコ 20 キシ基、アリールオキシ基またはヘテロ環オキシ基を表 す。) を表す。Ri 、R2 、R3 、R4 で表される脂肪 族炭化水素基として好ましくは、アルキル基(好ましく は炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~12、特 に好ましくは炭素数1~8であり、例えばメチル、エチ ル、iso-プロピル、tert-ブチル、n-オクチ ル、nーデシル、nーヘキサデシル、シクロプロピル、 シクロペンチル、シクロヘキシルなどが挙げられ る。)、アルケニル基(好ましくは炭素数2~20、よ り好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは炭素数2 -ペンテニルなどが挙げられる。)、アルキニル基(好 ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~1 2、特に好ましくは炭素数2~8であり、例えばプロパ ルギル、3-ペンチニルなどが挙げられる。) であり、 より好ましくはアルキル基、アルケニル基である。R ı、R2、R3、R4 で表されるアリール基として好ま しくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~2 0、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェ ニル、4ーメチルフェニル、4ーメトキシフェニル、3 40 ートリフルオロメチルフェニル、ペンタフルオロフェニ ル、1-ナフチル、2-ナフチルなどが挙げられる。R 1 、R2 、R3 、R4 で表されるヘテロ環基は、単環ま たは縮環のヘテロ環基 (好ましくは炭素数1~20、好 ましくは炭素数1~12、更に好ましくは炭素数2~1 0のヘテロ環基)であり、好ましくは窒素原子、酸素原 子、硫黄原子、セレン原子の少なくとも一つを含む芳香 族へテロ環基である。R1 、R2 、R3 、R4 で表され るヘテロ環基の具体例としては、例えばピロリジン、ピ ペリジン、ピロール、フラン、チオフェン、イミダゾリ シリルなどが挙げられる。) などが挙げられる。これら 50 ン、イミダゾール、ベンズイミダゾール、ナフトイミダ

15

ゾール、チアゾリジン、チアゾール、ベンズチアゾー ル、ナフトチアゾール、イソチアゾール、オキサゾリ ン、オキサゾール、ベンズオキサゾール、ナフトオキサ ゾール、イソオキサゾール、セレナゾール、ベンズセレ ナゾール、ナフトセレナゾール、ピリジン、キノリン、 イソキノリン、インドール、インドレニン、ピラゾー ル、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、トリアジン、 インダゾール、プリン、フタラジン、ナフチリジン、キ ノキサリン、キナゾリン、シンノリン、プテリジン、フ ェナントリジン、プテリジン、フェナントロリン、テト 10 ラザインデンなどが挙げられ、好ましくはフラン、チオ フェン、ピリジン、キノリン、ピラジン、ピリミジン、 ピリダジン、トリアジン、フタラジン、ナフチリジン、 キノキサリン、キナゾリンであり、より好ましくはフラ ン、チオフェン、ピリジン、キノリンである。

【0028】R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>で表されるアミノ 基として好ましくは、炭素数0~20、より好ましくは 炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であ り、例えばアミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジ エチルアミノ、ジベンジルアミノ、フェニルアミノ、ジ 20 フェニルアミノなどが挙げられる。R1、R2、R3、 R4 で表されるアルコキシ基として好ましくは、炭素数 1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好まし くは炭素数1~12であり、例えばメトキシ、エトキ シ、ブトキシ、2-エチルヘキシロキシなどが挙げられ る。 $R_1$  、 $R_2$  、 $R_3$  、 $R_4$  で表されるアリールオキシ 基として好ましくは、炭素数6~20、より好ましくは 炭素数6~16、特に好ましくは炭素数6~12であ り、例えばフェニルオキシ、4-メトキシフェニルオキ シ、1-ナフチルオキシ、2-ナフチルオキシなどが挙 30 げられる。R1 、R2 、R3 、R4 で表されるヘテロ環 オキシ基として好ましくは、炭素数1~20、より好ま しくは炭素数2~16、特に好ましくは炭素数2~12 であり、例えばピリジルオキシ、キノリルオキシなどが 挙げられる。

【0029】R1 、R2 、R3 、R4 は置換基を有して もよく、置換基としては例えば一般式(I)におけるQ 1 、Q2 で形成される環の置換基として挙げたものが適 用でき、また好ましい置換基も同様である。R1 、R2 ロ環基であり、より好ましくはアルキル基、アリール 基、芳香族へテロ環基である。R3 、R4 として好まし くは脂肪族炭化水素基、アリール基、ヘテロ環基、アル コキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環オキシ基であ り、より好ましくはアルコキシ基、アリールオキシ基で あり、更に好ましくはアリールオキシ基である。

【0030】Zとして好ましくはSO2 R1 であり、よ り好ましくはSO2 R5 (R5 は脂肪族炭化水素基、ア リール基、ヘテロ環基)であり、更に好ましくはSO2 R6 (R6 は脂肪族炭化水素基、アリール基、芳香族へ

テロ環基)であり、特に好ましくはSO2 R7 (R7 は アリール基)である。

【0031】一般式(I)で表される部分構造を有する 化合物のうち好ましくは、一般式(IV)、または (V)で表される部分構造を有する化合物またはその互 変異性体である。まず、一般式(IV)について詳細に説 明する。

[0032]

【化13】 一般式(IV)

【0033】(式中、R1 は脂肪族炭化水素基、アリー ル基、ヘテロ環基、アミノ基、アルコキシ基、アリール オキシ基、またはヘテロ環オキシ基を表す。Rai、 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd8 BLURd10 HEARE れ水素原子または置換基を表す。Yは酸素原子、硫黄原 子、N-R (Rは置換基を表す。)、CH2 もしくは置 換された炭素原子、またはセレン原子を表す。Q3 は環 を形成するのに必要な原子群を表す。)

【0034】R1 は一般式(I)におけるそれと同義で あり、また好ましい範囲も同様である。

[0035] Rd1、Rd2、Rd3、Rd4、Rd5 およびRd8 はそれぞれ水素原子または置換基を表し、置換基として は例えば、一般式(I)におけるQ1、Q2で形成され る環の置換基として挙げたものが適用でき、Rai、 Rd2、Rd3、Rd4、Rd5およびRd8として好ましくは、 水素原子、アルキル基、アルケニル基、アラルキル基、 アリール基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ 基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキ シカルボニル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基、ア ルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニ ルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイル基、 として好ましくは脂肪族炭化水素基、アリール基、ヘテ 40 カルバモイル基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ス ルホニル基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、 ヘテロ環基であり、より好ましくは水素原子、アルキル 基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、アシル基、 ハロゲン原子、シアノ基、ヘテロ環基であり、更に好ま しくは水素原子、アルキル基、シアノ基、ハロゲン原子 であり、特に好ましくは水素原子である。Raio は水素 原子または置換基を表し、置換基としては例えば、一般 式(I)における $Q_1$ 、 $Q_2$ で形成される環の置換基と して挙げたものが適用でき、Raio として好ましくは水 50 素原子、アルキル基、アルケニル基、アラルキル基、ア リール基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリー ルオキシカルボニル基であり、より好ましくは水素原 子、アルキル基であり、更に好ましくは水素原子、メチ ル基、エチル基であり、特に好ましくは水素原子であ

17

【0036】Yは酸素原子、硫黄原子、N-R (Rは置 換基を表す。)、CH2 もしくは置換された炭素原子、 またはセレン原子を表す。Rは一般式(I)におけるQ 1 、Q2 で形成される環の置換基として挙げたものが適 テロ環基であり、より好ましくはアルキル基、アリール 基、芳香族へテロ環基であり、更に好ましくはアリール 基、芳香族へテロ環基であり、特に好ましくはアリール 基(例えば、フェニル基、oーメチルフェニル基、mー メチルフェニル基、ナフチル基等がある。) である。 Y として好ましくは酸素原子、硫黄原子、N-Rであり、 より好ましくは、酸素原子、硫黄原子、N-Ry (Ry はアリール基、またはヘテロ環基を表す。)であり、特 に好ましくは酸素原子である。

【0037】Q3 は環を形成するのに必要な原子群を表 20 し、Q3 が形成する環の具体例としては不飽和の、炭化 水素環とヘテロ環が挙げられる。また、これらは単環で あってもよいし、さらに他の環と縮合環を形成してもよ

【0038】Q3 が形成する不飽和炭化水素環は芳香族 炭化水素環でも非芳香族炭化水素環でもよく、好ましく は芳香族炭化水素環(好ましくは炭素数6~30であ り、より好ましくは炭素数6~24、さらに好ましくは 炭素数6~20であり、特に好ましはベンゼン環、ナフ タレン環であり、最も好ましくはベンゼン環である。) である。

【0039】Q3 が形成するヘテロ環基は、N、Oまた はS原子を少なくとも一つを含む3ないし10員のヘテ ロ環基であり、これらは単環であってもよいし、更に他\* 一般式(V)

\*の環と縮合環を形成してもよい。ヘテロ環基として好ま しくは、芳香族ヘテロ環基であり、より好ましくは窒素 原子を含む芳香族へテロ環基である。ヘテロ環の具体例 としては、例えばピロリジン、ピペリジン、ピペラジ ン、モルフォリン、チオフェン、フラン、ピロール、イ ミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジン、ピリダ ジン、トリアゾール、トリアジン、インドール、インダ ゾール、プリン、チアゾリン、チアゾール、チアジアゾ ール、オキサゾリン、オキサゾール、オキサジアゾー 用でき、好ましくは脂肪族炭化水素基、アリール基、ヘ 10 ル、キノリン、イソキノリン、フタラジン、ナフチリジ ン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、プテリジ ン、アクリジン フェナントロリン、フェナジン、ベン ズイミダゾール、ベンズオキサゾール、ベンズチアゾー ル、ベンゾトリアゾール、テトラザインデンなどが挙げ られる。ヘテロ環として好ましくは、ピロール、イミダ ゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジン、ピリダジ ン、トリアゾール、トリアジン、インドール、インダゾ ール、チアジアゾール、オキサジアゾール、キノリン、 フタラジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、 チアゾール、オキサゾール、ベンズイミダゾール、ベン ズオキサゾール、ベンズチアゾール、ベンゾトリアゾー ルであり、より好ましくはイミダゾール、ピリジン、キ ノリン、チアゾール、オキサゾール、ベンズイミダゾー ル、ベンズオキサゾール、ベンズチアゾール、ベンゾト リアゾールであり、更に好ましくは、ピリジン、キノリ ンである。

> 【0040】Q3 として好ましくは芳香族炭化水素環、 芳香族へテロ環であり、より好ましくは炭素数6~20 の芳香族炭化水素環、窒素原子を含む芳香族へテロ環で 30 あり、更に好ましくはベンゼン環、ピリジン環キノリン 環である。次に、一般式 (V) について詳細に説明す る。

【化14】 Raa Ra24

[0041]

【0042】(式中、Rd1、Rd2、Rd3、Rd4、Rd5、 Rd6, Rd7, Rd8, Rd10, Rd21, Rd22, Rd23 \$ よびRd24 はそれぞれ水素原子または置換基を表す。X 5 は酸素原子、硫黄原子、置換もしくは無置換の窒素原 子、C Hz もしくは置換された炭素原子、またはセレン※50 X1と同義であり、また好ましい範囲も同様である。

#### ※原子を表す。)

【0043】Rd1、Rd2、Rd3、Rd4、Rd5、Rd8およ びRaio はそれぞれ一般式 (IV) と同義であり、また好 ましい範囲も同様である。X5 は一般式(I)における

[0044] Rd6, Rd7, Rd21, Rd22, Rd23 BJ びRd24 はそれぞれ水素原子または置換基を表し、置換 基としては例えば、一般式(I)における $Q_1$ 、 $Q_2$ で 形成される環の置換基として挙げたものが適用でき、R d6 Rd7 Rd21 Rd22 Rd23 BLURd24 ELT 好ましくは、水素原子、アルキル基、アルケニル基、ア ラルキル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、ア リールオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、 アリールオキシカルボニル基、アシルオキシ基、アシル キシカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルフ ァモイル基、カルバモイル基、アルキルチオ基、アリー ルチオ基、スルホニル基、ヒドロキシ基、ハロゲン原 子、シアノ基、ヘテロ環基であり、より好ましくは水素 原子、アルキル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ 基、アシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ヘテロ環基で あり、更に好ましくは水素原子、アルキル基、シアノ 基、ハロゲン原子であり、特に好ましくは水素原子であ

19

【0045】一般式(I)で表される部分構造を有する 化合物またはその互変異性体を配位子とする金属錯体の うち、好ましくは下記一般式 (K-I)で表される金属 錯体である。以下に一般式(K-I)について詳細に説 明する。

[0046]

【化15】 **─般式(K-I)** 

$$\begin{bmatrix} Q_1 & & & \\ & N & & \\ Q_2 & & N & \\ & & Z \end{bmatrix}_m M - Ln$$

→般式(K-Ia)

【0047】(式中、Q1、Q2 およびZは、それぞれ 一殷式(I)におけるそれらと同義であり、また好まし い範囲も同様である。Mは金属イオンを表し、好ましく は2個または3個の金属イオンである。Mで表される金 属イオンの具体例としては、ベリリウムイオン、マグネ シウムイオン、カルシウムイオン、アルミニウムイオ ン、ガリウムイオン、インジウムイオン、ジルコニウム イオン、亜鉛イオン、鉄イオン、コバルトイオン、ニッ 40 ケルイオン、銅イオン、白金イオン、パラジウムイオ ン、ストロンチウムイオン、スカンジウムイオン、テル\*

\* ビウムイオンなどが挙げられ、好ましくはベリリウムイ オン、マグネシウムイオン、アルミニウムイオン、ガリ ウムイオン、亜鉛イオンであり、より好ましくはベリリ ウムイオン、アルミニウムイオン、亜鉛イオンであり、 更に好ましくは亜鉛イオンである。mは1~3の整数を 表し、好ましくは金属錯体が中性となるような整数であ

【0048】Lは配位子を表す。Lで表される配位子と して好ましくは一般式(I)で表される配位子、アルコ アミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオ 10 キシ基 (好ましくは炭素数 1 ~30、より好ましくは炭 素数1~20、特に好ましくは炭素数1~10であり、 例えばメトキシ、エトキシ、ブトキシ、2-エチルヘキ シロキシなどが挙げられる。)、アリールオキシ基(好 ましくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~2 0、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェ ニルオキシ、1ーナフチルオキシ、2ーナフチルオキシ などが挙げられる。)、ヘテロアリールオキシ基(好ま しくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばピリ ジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリミジルオキシ、キノ 20 リルオキシなどが挙げられる。)、アルキルチオ基(好 ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメチ ルチオ、エチルチオなどが挙げられる。)、アリールチ オ基(好ましくは炭素数6~30、より好ましくは炭素 数6~20、特に好ましくは炭素数6~12であり、例 えばフェニルチオなどが挙げられる。)、ヘテロアリー ルチオ基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは 炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~12であ 30 り、例えばピリジルチオ、2-ベンズイミゾリルチオ、 2-ベンズオキサゾリルチオ、2-ベンズチアゾリルチ オなどが挙げられる。)であり、より好ましくは一般式 (I)で表される配位子、アリールオキシ基、ヘテロア リールオキシ基であり、更に好ましくは一般式(I)で 表される配位子、アリールオキシ基である。nはm+n =2または3となる整数を表し、好ましくは0または1 である。

> 【0049】一般式(K-I)で表される化合物のう ち、好ましくは一般式 (K-Ia) で表される化合物で ある。

[0050]

【化16】

【0051】(式中、Q1、Q2 およびR1は、それぞ※50※れ一般式(I)におけるそれらと同義であり、また好ま

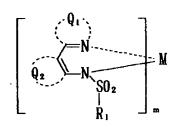
しい範囲も同様である。M、m、Lおよびnは、それぞれ一般式(K-I)におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。)

【0052】一般式(K-I)で表される化合物のうち、より好ましくは一般式(K-Ib)で表される化合物である。

[0053]

【化17】

# 一般式 (K-Ib)



【0054】(式中、Q1、Q2 およびR1 は、それぞれ一般式(I)におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。Mおよびmは、それぞれ一般式(K-I)におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。)

一般式(K — I )で表される化合物のうち、更に好ましくは一般式(K — I c)で表される化合物である。

[0055]

【化18】

# 一般式(K-Ic)

Q'1 N SO 2 M 30

一般式 (K-Id)

【0059】(式中、 $R_1$  は一般式(I)におけるそれ と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Mおよ びmは、それぞれ一般式(K-I)におけるそれらと同 義であり、また好ましい範囲も同様である。 $X_5$ 、

Re1、Re2、Re3、Re4、Re5、Re6、Re7およびRes は、それぞれ一般式(V)におけるそれらと同義であ ※

\*【0056】(式中、R1は一般式(I)におけるそれ と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Mおよ びmは、それぞれ一般式(K-I)におけるそれらと同 義であり、また好ましい範囲も同様である。Q1'は前記 Q1と同義である。Q2'は6員の芳香族環を形成するに 必要な原子群を表す。Q2'で形成される6員の芳香族環 としては、例えばベンゼン、ナフタレン、ピリジン、ピ ラジン、ピリミジン、ピリダジン、トリアジンなどが挙 げられ、好ましくはベンゼン、ナフタレン、ピリジン、 10 ピラジン、ピリミジン、ピリダジンであり、より好まし くはベンゼン、ナフタレン、ピリジンであり、更に好ま しくはベンゼン、ナフタレンである。Q2'で形成される 6員の芳香族環は置換基を有してもよく、置換基として は例えば一般式(I)におけるQ1、Q2で形成される 環の置換基として挙げたものが適用でき、また好ましい 置換基も同様である。これらの置換基は可能な場合には 連結して環を形成してもよい。)

22

【0057】一般式 (K-I)で表される化合物のうち、特に好ましくは一般式 (K-Id)で表される化合20 物である。

[0058]

【化19】

【化20】

24

[0061]

\*【化21】

-般式 (K-V)

【0062】まず、一般式 (K-IV) について詳細に説 明する。

【0063】(式中、R1、Rd1、Rd2、Rd3、Rd4、 . Rd5、Rd8およびQ3 はそれぞれ一般式 (IV) におけ るそれらと同義であり、また、好ましい範囲も同様であ る。Mおよびmはそれぞれ一般式(I)におけるそれら 30 と同義であり、また好ましい範囲も同様である。X5は ※ 一般式(K-IV-a)

※一般式(K-Id)におけるそれと同義であり、また好ま しい範囲も同様である。)

【0064】一般式 (K-IV) で表される化合物のうち 好ましくは一般式(K-IV-a)である。

[0065]

【化22】

【0066】(式中、R1、Rd1、Rd2、Rd3、Rd4、 Rd5、Rd8およびX5 はそれぞれ一般式 (K-IV) にお けるそれらと同義であり、また、好ましい範囲も同様で ある。Mおよびmは一般式(I)におけるそれらと同義 であり、また好ましい範囲も同様である。Rd31 、R d32 、Rd33 、およびRd34 は水素原子または置換基を 表し、置換基としては一般式(I)におけるQ1、Q2 で形成される環の置換基として挙げたものが適用でき ★50 イル基、カルバモイル基、アルキルチオ基、アリールチ

★る。Rd31 、Rd32 、Rd33 、およびRd34 として好ま しくは、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アラル キル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、アリー ルオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリ ールオキシカルボニル基、アシルオキシ基、アシルアミ ノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシ カルポニルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルファモ

オ基、スルホニル基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、ヘテロ環基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、アシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ヘテロ環基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基、シアノ基、ハロ\*一般式(K-IV-b)

25

\* ゲン原子であり、特に好ましくは水素原子である。) 【0067】一般式 (K-IV) で表される化合物のうち より好ましくは一般式 (K-IV-b) である。 【0068】 【化23】

【0069】(式中、R1、Rd1、Rd2、Rd3、Rd4、Rd5およびRd8はそれぞれ一般式(IV)におけるそれらと同義であり、また、好ましい範囲も同様である。Mおよびmは一般式(I)におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。Rd31、Rd32、Rd33、およびRd34 はそれぞれ一般式(K-IV-a)と※一般式(K-IV-c)

※同義であり、また、この好ましい範囲も同様である。) 【0070】一般式(K-IV)で表される化合物のうち 更に好ましくは一般式(K-IV-c)である。 【0071】

【0071】 【化24】

【0072】(式中、R1、Rd1、Rd2、Rd3、Rd4、Rd5およびRd8はそれぞれ一般式(IV)におけるそれらと同義であり、また、好ましい範囲も同様である。Rd31、Rd32、Rd33、およびRd34はそれぞれ一般式(K-IV-a)と同義であり、また、この好ましい範囲も同様である。)

【0073】次に一般式(K-V)について詳細に説明 40 する。一般式(K-V)中、Rd1、Rd2、Rd3、Rd4、 Rd5、Rd6、Rd7、Rd8、Rd21 、Rd22 、Rd23 、R★

★d24 およびX5 はそれぞれ一般式 (V) におけるそれら と同義であり、また、好ましい範囲も同様である。Mお よびmは一般式 (I) におけるそれらと同義であり、ま た好ましい範囲も同様である。一般式 (K-V) で表さ れる化合物のうち好ましくは一般式 (K-V-a) で表 される化合物である。

【0074】 【化25】 27 一般式 (K-V-a)

【0075】(式中、Rd1、Rd2、Rd3、Rd4、Rd5、Rd6、Rd7、Rd8、Rd21 、Rd22、Rd23 およびRd24 はそれぞれ一般式(V)におけるそれらと同義であり、また、好ましい範囲も同様である。Mおよびmは一般式(I)におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。)

一般式 (K-V-b)

\*【0076】一般式 (K-V)で表される化合物のうちより好ましくは一般式 (K-V-b)で表される化合物である。

28

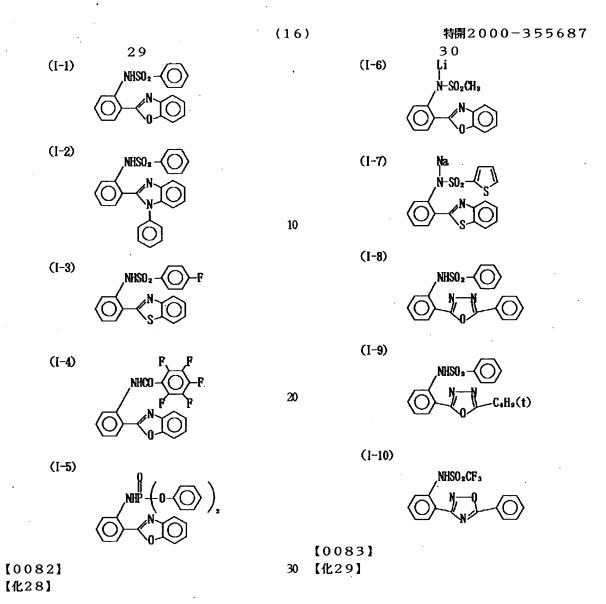
【0077】 【化26】

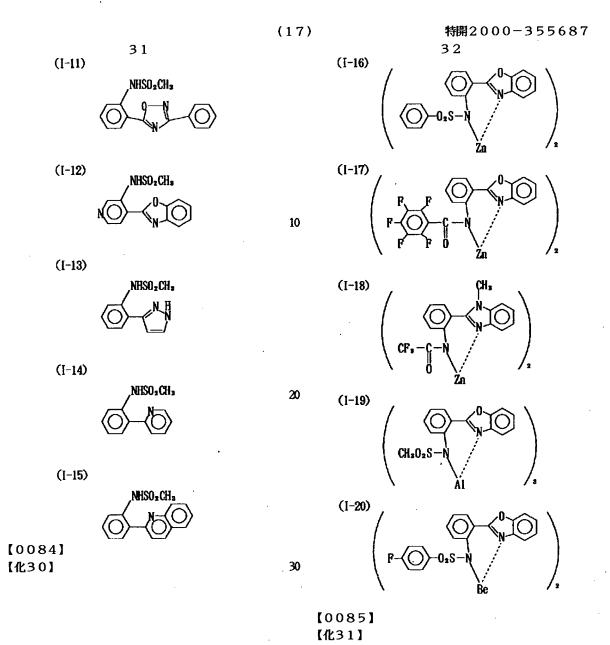
【0078】(式中、Rd1、Rd2、Rd3、Rd4、Rd5、 Rd6、Rd7、Rd8、Rd21 、Rd22、Rd23 およびR d24 はそれぞれ一般式 (V) におけるそれらと同義であ り、また、好ましい範囲も同様である。) 【0079】なお、一般式(I)、(K-I)、(K-Ia) (K-Ib) (K-Ic) (K-Id) .(IV), (K-IV), (K-IV-a), (K-IV-b) (K-IV-c) (V) (K-V)(K-V-a)、(K-V-b)で表される化合物は、 低分子量化合物であってもよいし、一般式(I)、(K -I) (K-Ia) (K-Ib) (K-Ic)(K-Id), (IV), (K-IV), (K-IV-IV)a) (K-IV-b) (K-IV-c) (V)(K-V)、(K-V-a)、(K-V-b)で表され る残基がポリマー主鎖に接続された高分子量化合物もし くは、一般式(I)、(K-Ia)、(K-Ia)、(K -Ib) (K-Ic) (K-Id) (IV)(K-IV), (K-IV-a), (K-IV-b), %50

※(K-IV-c)、(V)、(K-V)、(K-V-a)、(K-V-b)の骨格を主鎖にもつ高分子量化合物であってもよい。高分子量化合物の場合は、ホモボリマーであっても良いし、他のモノマーとの共重合体であっても良い。また、一般式(I)、(K-I)、(K-Ia)、(K-Ib)、(K-Ic)、(K-Id)、(IV)、(K-IV)、(K-IV-a)、(K-I
 V-b)、(K-IV-c)、(V)、(K-V)、(K-V-a)、(K-V-a)、(K-V-b)および、以下に示すこれらの具体的化合物例は便宜的に極限構造式で表しているが、その互変異性体であってもよい。

【0080】以下に本発明の一般式(I)で表される部分構造を有する化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0081】 【化27】





# (1-24)

# (I-25)

[0086]

\*30\*【化32】

$$(I-31) \qquad C_{2}H_{5} \qquad (I-32) \qquad 0 \qquad C_{4}H_{9}(t)$$

$$(CH_{2}SO_{2}-N) \qquad Al CH_{2} \qquad CH_{3}$$

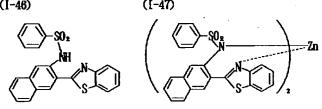
$$(I-24) \qquad (I-24)$$

[0087]

\* \*【化33】

[0088]

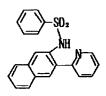
\* \*【化34】

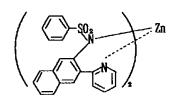


(0089) \* \* (化35)

4 1 (I-50)

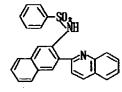
(I-51)

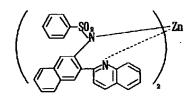




(1-52)

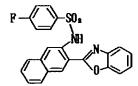
([-53)

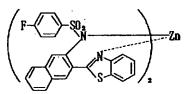




(I-54)

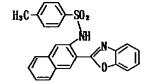
(I-55)

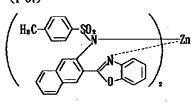




(I-56)

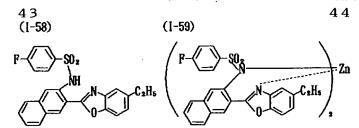
(1-57)





[0090]

\* \*【化36】



(1-60) (I-61)

(1-63) (I-62)

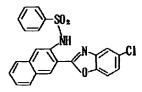
(I-65) (I-64) \*【化37】

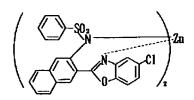
[0091]

<u>4</u> 5

(I-66)

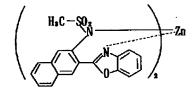
(1-67)





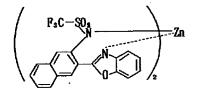
(I-68)

(I-69)



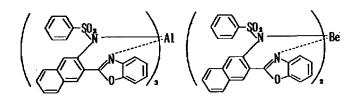
(I-70)

(I-71)



(1-72)

([-73)



[0092]

\* \*【化38】

(1-76) (1-77)

(1-77)

(1-77)

(1-77)

(1-78) (1-79)

Zn (1-79)

Zn (1-79)

【0093】一般式(I)で表される部分構造を有する 化合物またはその互変異性体を配位子に有する金属錯体 の合成は、配位子を合成すると同時に錯体化しても、ま た一旦単離した配位子を用いて金属または金属塩との反 応により合成することもできる。本発明の金属錯体の合 30 成に際して原料に用いる金属塩としては、特に限定はな いが硝酸塩、ハロゲン塩(フッ化物、塩化物、臭化物、 ヨウ化物など)、硫酸塩、カルボン酸塩(酢酸塩な ど)、ホスホン酸塩、スルホン酸塩、水酸化物などが好 適に用いられ、好ましくは硝酸塩、塩酸塩、硫酸塩、酢 酸塩である。金属錯体を合成する際に用いる配位子と金 属塩のモル比は合成する錯体に応じて適宜選択するが、 通常金属イオンに対して配位子を0.1~10倍モル、 好ましくは0.5~8倍モル、更に好ましくは0.5~ 6倍モルである。また、錯体の合成に際しては塩基を用 いることができる。塩基としては、種々の無機または有 機塩基を用いることができ、例えば金属水酸化物(例え ば水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなど)、金属炭酸 塩(例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなど)、金属 炭酸水素塩(例えば炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリ ウムなど)、有機塩基(例えばトリエチルアミン、ナト リウムアルコキシドなど)の使用が好ましい。使用する 塩基の量は、特に限定しないが、好ましくは配位子に対 して0.01当量~30当量、より好ましくは1当量~

10当量である。金属錯体の合成に際しては溶媒を用い\*50

\*てもよく、溶媒としては特に限定はないが水、アルコー ル類 (例えばメタノール、エタノール、2-プロパノー ルなど)、エステル類(例えば酢酸エチルなど)、エー テル類(例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラ ン、1、4-ジオキサンなど)、アミド類(例えばジメ チルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなど)、ニト リル類(例えばアセトニトリルなど)、ケトン類(例え ばアセトン、シクロヘキサノンなど)、炭化水素類(例 えばヘキサン、ベンゼン、トルエンなど)、ハロゲン化 炭化水素類(例えばジクロロメタン、クロロホルム、 1, 2-ジクロロエタンなど)、カルボン酸類(例えば 酢酸など) などを用いることができる。 また、これら溶 媒を混合して用いてもよい。溶媒として好ましくはアル コール類、エーテル類、ケトン類であり、より好ましく はアルコール類であり、特に好ましくはメタノール、エ タノール、2-プロパノールである。 金属錯体を合成 する際の反応温度は特に限定はないが、好ましくは10 ~150°C、好ましくは10~100°C、より好ましく は10~80℃である。

【0094】次に、本発明の化合物を含有する発光素子 に関して説明する。本発明の発光素子は、本発明の化合 物を利用する素子であればシステム、駆動方法、利用形 態など特に問わないが、本発明の化合物からの発光を利 用するもの、または本化合物を電荷輸送材料として利用 するものが好ましい。代表的な発光素子として有機EL (エレクトロルミネッセンス) 素子を挙げることができる。

49

【0095】本発明の化合物を含有する発光素子の有機層の形成方法は、特に限定されるものではないが、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム法、スパッタリング法、分子積層法、コーティング法、インクジェット法、印刷法などの方法が用いられ、製造面で抵抗加熱蒸着法、コーティング法が好ましく、抵抗加熱蒸着法がより好ましい。 【0096】本発明の発光素子は陽極、陰極の一対の電極間に発光層よりくは発光層を含む複数の有機化合物薄

【0096】本発明の発光素子は陽極、陰極の一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合物薄膜を形成した素子であり、発光層のほか正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、電子輸送層、保護層などを有してもよく、またこれらの各層はそれぞれ他の機能を備えたものであってもよい。各層の形成にはそれぞれ種々の材料を用いることができる。

【0097】陽極は正孔注入層、正孔輸送層、発光層な どに正孔を供給するものであり、金属、合金、金属酸化 物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物などを用 いることができ、好ましくは仕事関数が4eV以上の材 料である。具体例としては酸化スズ、酸化亜鉛、酸化イ ンジウム、酸化インジウムスズ (ITO)等の導電性金 属酸化物、あるいは金、銀、クロム、ニッケル等の金 属、さらにこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物 または積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物 質、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなど の有機導電性材料、およびこれらとITOとの積層物な どが挙げられ、好ましくは、導電性金属酸化物であり、 特に、生産性、高導電性、透明性等の点からITOが好 ましい。陽極の膜厚は材料により適宜選択可能である が、通常10 n m~5 μ m の範囲のものが好ましく、よ 30 り好ましくは5.0 nm~1μmであり、更に好ましくは 100nm~500nmである。

【0098】陽極は通常、ソーダライムガラス、無アル カリガラス、透明樹脂基板などの上に層形成したものが 用いられる。ガラスを用いる場合、その材質について は、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アル カリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダライ ムガラスを用いる場合、シリカなどのバリアコートを施 したものを使用することが好ましい。基板の厚みは、機 械的強度を保つのに十分であれば特に制限はないが、ガ 40 ラスを用いる場合には、通常O. 2mm以上、好ましく は0.7mm以上のものを用いる。陽極の作製には材料 によって種々の方法が用いられるが、例えばITOの場 合、電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着 法、化学反応法(ゾルーゲル法など)、酸化インジウム スズの分散物の塗布などの方法で膜形成される。陽極は 洗浄その他の処理により、素子の駆動電圧を下げたり、 発光効率を高めることも可能である。例えば I TOの場 合、UV-オゾン処理、プラズマ処理などが効果的であ る。

【0099】陰極は電子注入層、電子輸送層、発光層な どに電子を供給するものであり、電子注入層、電子輸送 層、発光層などの負極と隣接する層との密着性やイオン 化ポテンシャル、安定性等を考慮して選ばれる。陰極の 材料としては金属、合金、金属ハロゲン化物、金属酸化 物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物を用いる ことができ、具体例としてはアルカリ金属(例えばし i、Na、K、Cs等) 及びそのフッ化物、アルカリ土 類金属 (例えばMg、Ca等) 及びそのフッ化物、金、 銀、鉛、アルミニウム、ナトリウムーカリウム合金また 10 はそれらの混合金属、リチウムーアルミニウム合金また はそれらの混合金属、マグネシウムー銀合金またはそれ らの混合金属、インジウム、イッテリビウム等の希土類 金属等が挙げられ、好ましくは仕事関数が4 e V以下の 材料であり、より好ましくはアルミニウム、リチウムー アルミニウム合金またはそれらの混合金属、マグネシウ ムー銀合金またはそれらの混合金属等である。陰極は、 上記化合物及び混合物の単層構造だけでなく、上記化合 物及び混合物を含む積層構造を取ることもできる。陰極 の膜厚は材料により適宜選択可能であるが、通常10n 20 m~5µmの範囲のものが好ましく、より好ましくは5  $0nm\sim1\mu$ mであり、更に好ましくは $100nm\sim1$ μmである。陰極の作製には電子ビーム法、スパッタリ ング法、抵抗加熱蒸着法、コーティング法などの方法が 用いられ、金属を単体で蒸着することも、二成分以上を 同時に蒸着することもできる。さらに、複数の金属を同 時に蒸着して合金電極を形成することも可能であり、ま たあらかじめ調整した合金を蒸着させてもよい。陽極及 **び陰極のシート抵抗は低い方が好ましく、数百**Ω/□以 下が好ましい。

50

【0100】発光層の材料は、電界印加時に陽極または 正孔注入層、正孔輸送層から正孔を注入することができ ると共に陰極または電子注入層、電子輸送層から電子を 注入することができる機能や、注入された電荷を移動さ せる機能、正孔と電子の再結合の場を提供して発光させ る機能を有する層を形成することができるものであれば 何でもよい。好ましくは発光層に本発明の化合物を含有 するものであるが、他の発光材料を用いることもでき る。例えばベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾ ール誘導体、ベンゾチアゾール誘導体、スチリルベンゼ ン誘導体、ポリフェニル誘導体、ジフェニルブタジエン 誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ナフタルイ ミド誘導体、クマリン誘導体、ペリレン誘導体、ペリノ ン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アルダジン誘導 体、ピラリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、ビ ススチリルアントラセン誘導体、キナクリドン誘導体、 ピロロピリジン誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、 シクロペンタジエン誘導体、スチリルアミン誘導体、芳 香族ジメチリディン化合物、8-キノリノール誘導体の 50 金属錯体や希土類錯体に代表される各種金属錯体等、ボ

リチオフェン、ポリフェニレン、ポリフェニレンビニレ ン等のポリマー化合物、有機シラン誘導体等が挙げられ る。発光層の膜厚は特に限定されるものではないが、通 常1 n m~5 μ m の範囲のものが好ましく、より好まし くは5 nm~1 μmであり、更に好ましくは10 nm~ 500 nmである。発光層の形成方法は、特に限定され るものではないが、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム法、ス パッタリング法、分子積層法、コーティング法(スピン コート法、キャスト法、ディップコート法など)、LB 法、インクジェット法、印刷法などの方法が用いられ、 好ましくは抵抗加熱蒸着法、コーティング法である。 【0101】正孔注入層、正孔輸送層の材料は、陽極か ら正孔を注入する機能、正孔を輸送する機能、陰極から 注入された電子を障壁する機能のいずれか有しているも のであればよい。その具体例としては、カルバゾール誘 **導体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキ** サジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリー ルアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導 体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導 体、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアントラセン 20 誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラソン誘導体、スチ ルベン誘導体、シラザン誘導体、芳香族第三級アミン化 合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリディン系 化合物、ポルフィリン系化合物、ポリシラン系化合物、 ポリ (N-ビニルカルバゾール)誘導体、アニリン系共 重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導 電性高分子オリゴマー、有機シラン誘導体等が挙げられ る。正孔注入層、正孔輸送層の膜厚は特に限定されるも のではないが、通常1 nm~5μmの範囲のものが好ま しく、より好ましくは5 nm~1 μmであり、更に好ま 30 しくは10nm~500nmである。正孔注入層、正孔 輸送層は上述した材料の1種または2種以上からなる単 層構造であってもよいし、同一組成または異種組成の複 数層からなる多層構造であってもよい。正孔注入層、正 孔輪送層の形成方法としては、真空蒸着法、LB法、イ ンクジェット法、印刷法、前記正孔注入輸送剤を溶媒に 溶解または分散させてコーティングする方法(スピンコ ート法、キャスト法、ディップコート法など)が用いら れる。コーティング法の場合、樹脂成分と共に溶解また は分散することができ、樹脂成分としては例えば、ポリ 塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリメ チルメタクリレート、ポリブチルメタクリレート、ポリ エステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオキシド、ポ リブタジエン、ポリ(N-ビニルカルバゾール)、炭化 水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、 エチルセルロース、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレ タン、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキ ド樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂などが挙げられ る。

ら電子を注入する機能、電子を輸送する機能、陽極から 注入された正孔を障壁する機能のいずれか有しているも のであればよい。その具体例としては、トリアゾール誘 導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、 フルオレノン誘導体、アントラキノジメタン誘導体、ア ントロン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピラン ジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレニ リデンメタン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフ タレン、ペリレン等の複素環テトラカルボン酸無水物、 10 フタロシアニン誘導体、8-キノリノール誘導体の金属 錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベ ンゾチアゾールを配位子とする金属錯体に代表される各 種金属錯体、有機シラン誘導体、本発明の化合物等が挙 げられる。電子注入層、電子輸送層の膜厚は特に限定さ れるものではないが、通常1nm~5µmの範囲のもの が好ましく、より好ましくは5 nm~1 umであり、更 に好ましくは10nm~500nmである。電子注入 層、電子輸送層は上述した材料の1種または2種以上か らなる単層構造であってもよいし、同一組成または異種 組成の複数層からなる多層構造であってもよい。電子注 入層、電子輸送層の形成方法としては、真空蒸着法、L B法、インクジェット法、印刷法、前記電子注入輸送剤 を溶媒に溶解または分散させてコーティングする方法 (スピンコート法、キャスト法、ディップコート法な ど) などが用いられる。コーティング法の場合、樹脂成 分と共に溶解または分散することができ、樹脂成分とし ては例えば、正孔注入輸送層の場合に例示したものが適 用できる。

52

【0103】保護層の材料としては水分や酸素等の素子 劣化を促進するものが素子内に入ることを抑止する機能 を有しているものであればよい。その具体例としては、 In, Sn, Pb, Au, Cu, Ag, Al, Ti, N i等の金属、MgO、SiO、SiO2、Al2 O3、 GeO, NiO, CaO, BaO, Fe2 O3, Y2O3 、TiOz 等の金属酸化物、MgFz、LiF、Al F3、CaF2等の金属フッ化物、ポリエチレン、ポリ プロピレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、 ポリウレア、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロ トリフルオロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレ ン、クロロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロ エチレンとの共重合体、テトラフルオロエチレンと少な くとも1種のコモノマーとを含むモノマー混合物を共重 合させて得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有 する含フッ素共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質、 吸水率0.1%以下の防湿性物質等が挙げられる。保護 層の形成方法についても特に限定はなく、例えば真空蒸 着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、M BE (分子線エピタキシ) 法、クラスターイオンビーム 法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法(高周波 【0102】電子注入層、電子輸送層の材料は、陰極か 50 励起イオンプレーティング法)、プラズマCVD法、レ

ーザーCVD法、熱CVD法、ガスソースCVD法、コ ーティング法、インクジェット法、印刷法を適用でき る.

#### [0104]

【実施例】以下に本発明の具体的実施例を述べるが、本 発明の実施の態様はこれらに限定されない。

### (I-1)の合成

化合物a5g、o-アミノフェノール2.4gをジメチ ルホルムアミド50m1に溶解し、これに、ジシクロへ キシルカルボジイミド (DCC) を5.6g添加した。 室温で3時間攪拌した後、酢酸エチル200m1、一規 定塩酸水200m1で希釈し、分離した有機層を一規定 塩酸水200m1、水200m1、飽和食塩水100m\*

\* 1でそれぞれ洗浄した。硫酸ナトリウムで乾燥、ろ過後 濃縮した後、カラムクロマトグラフィー(展開溶媒クロ ロホルム)により精製し、淡黄色固体3.5gを得た。 この化合物3.5gにp-キシレン50mlを加え、p ートルエンスルホン酸一水和物0.1gを添加した。溶 液を2時間加熱還流し、同時にディーンスターク装置に より留出する水を除去した。溶液にメタノールを加え、 析出した結晶をろ別した。再結晶(クロロホルム/メタ ノール)により精製し、白色固体(I-1)1.4gを 10 得た。質量分析により、(I-1)の構造を確認した。 [0105] 【化39】

【0106】(I-16)の合成

(I-1)0. 4gにメタノール10mlを加え、Me ONaのメタノール溶液 (28wt%) 0. 22mlを 満下した、滴下終了後、反応液は均一系になった。室温 で5分間攪拌後、酢酸亜鉛2水和物0.13gを添加 し、加熱還流下1時間攪拌した。析出した固体をろ別 ※30 (I-16)の合成

※し、青色蛍光を有する白色固体(I-16)0.35g を得た。

融点:300℃以上 [0107]

【化40】

NHSO<sub>2</sub> 
$$\longrightarrow$$
 MeONa  $Z_{1}(0Ac)_{2} \cdot 2H_{2}O$  (I-16)

NHEOH reflux

【0108】(I-42)の合成

3-アミノ-2-ナフトン酸15.0g(80mmo 1)、ベンゼンスルホニルクロライド14.1g(80 mmol)、アセトニトリル100mLを激しく撹拌し、 ピリジン6.3gを室温で滴下した後、反応溶液を2時 間加熱還流する。反応溶液を室温まで冷却した後、クロ ロホルム、メタノール、1 N塩酸水溶液で抽出操作を行 い、有機相を回収し、硫酸ナトリウムで乾燥、沪過後、 溶媒を減圧留去し、白色の固体を得た。得られた固体に クロロホルム200mLを加え、ピリジン9.7mL  $(120 \text{ mmol}), 2-7 \le 1/2 \le$ (96 mmol)、ジシクロヘキシルカルボジイミド(D

★還流した。反応溶液を室温まで冷却した後、クロロホル ム、飽和食塩水で抽出操作を行い、有機相を回収し、硫 40 酸ナトリウムで乾燥、沪過後、溶媒を減圧留去し、シリ カゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン-酢酸エチ ル、9/1~5/5、w/w) により精製操作を行い化 合物bを10.0g (収率30%) 得た。

【0109】化合物b10.0g(23.8mmol) にキシレン150mLを加え、触媒としてpートルエン スルホン酸一水和物230mgを添加し、8時間加熱還 流した後、反応溶液を室温まで冷却し、クロロホルム、 飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で抽出操作を行い、有機 相を回収し、硫酸ナトリウムで乾燥、沪過後、溶媒を減 CC) 24.7g(120mmol)を加え、3時間加熱★50 圧留去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキ

サン-クロロホルム)により精製操作を行い化合物(I \* [0110] 【化41】 -42) を1.1g (収率12%) 得た。質量分析によ り構造を確認した。

# 【0111】(I-43)の合成

化合物 (I-42) 250mg (0.62mmol) にエ タノール100mL、クロロホルム10mLを加え、加 1 mmol)をエタノール5mLに溶解させたものをゆっ くりと滴下した。滴下後反応液を10時間加熱湿流し、 反応液が熱いうちに熱時沪過を行い、黄色の結晶として 化合物 (I-43)を120mg (22%)得た。元素 分析により得られた結晶の組成を確かめた。

### 元素分析

calcd. C 63.93% H 3.50% N 6.48%

Found C 63.76% H 3.58% N 6.42%

融点: 300℃以上

### 比較例1

洗浄したITO基板を蒸着装置内に入れ、基板上にTP D(N, N'ージフェニルーN, N'ージ(mートリ ル) ベンジジン) を40 n m 蒸着し、この上に化合物A を20 nm蒸着し、さらにこの上にA1q(トリス(8 ーヒドロキシキノリナト) アルミニウム錯体) 40 nm を蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマスク(発 光面積が5mm×5mmとなるマスク)を設置し、蒸着 装置内でマグネシウム:銀=10:1を50nm共蒸着※50

※した後、銀50nmを蒸着してEL素子を作製した。東 陽テクニカ製ソースメジャーユニット2400型を用い て、直流定電圧をEL素子に印加し発光させ、その輝度 熱湿流した後、酢酸亜鉛二水和物68.4mg(0.3 30 をトプコン社の輝度計BM-8、発光波長を浜松フォト ニクス社製スペクトルアナライザーPMA-11を用い て測定した。その結果、色度値(0.19,0.30) の青緑色発光が得られ、13Vで2400cd/m²の 輝度が得られた。

> [0112] 【化42】 化合物A

# 【0113】実施例1

Alqの代わりに、本発明の化合物(I-16)を用 い、比較例1と同様に素子を作製して評価した。その結 果、色度値(0.16,0.16)の色純度の高い青色 発光が得られ、13Vで2500cd/m²の輝度が得 られた。

【0114】実施例2

洗浄した I TO基板を蒸着装置内に入れ、基板上に $\alpha$  – NPD (N, N' – ジフェニルーN, N' – ジ ( $\alpha$  – ナフチル) ベンジジン) を 40 n m蒸着し、この上に化合物 (I – 29) を 60 n m蒸着し、比較例 1 と同様に陰極を蒸着してE L 素子を作製した。比較例 1 と同様に素子の評価をした。その結果、色度値(0. 16, 0. 17) の青色発光が得られ、15 Vで 1200 c d 16 の輝度が得られた。

#### 【0115】実施例3

ポリ (Nービニルカルバゾール) 40mg、(I-22)6mgを1, 2ージクロロエタン3m1に溶解し、洗浄したITO基板上にスピンコートした。生成した有機薄膜の膜厚は、約100nmであった。比較例1と同様に陰極を蒸着してEL素子を作製した。比較例1と同様に素子の評価をし、その結果、色度値(0.15,0.17)の青色発光が得られ、20Vで440cd/m²の輝度が得られた。

## 【0116】実施例4

洗浄した I TO基盤を蒸着装置内に入れ、基板上にαーNPDを40nm蒸着し、この上に例示化合物 I - 43 20を20nm蒸着し、更にこの上に電子輸送材料として化合物 Bを40nm積層し、比較例1と同様に陰極を蒸着してLL素子を作製した。その結果、色度座標(0.30,0.54)の緑色発光が得られ、16Vで1035 cd/m²の輝度が得られた。

【0117】 【化43】

化合物B

# 【0118】実施例5

洗浄した I TO基盤を蒸着装置内に入れ、基板上にαーNPDを40nm蒸着し、この上に例示化合物 I - 4 3、化合物C(赤色発光ドープ色素)(蒸着レート100:1)を20nm蒸着し、更にこの上に化合物Bを40nm積層し、比較例1と同様に陰極を蒸着してEL素子を作製した。その結果、色度座標(0.66,0.32)の赤色発光が得られ、15Vで823cd/m²の輝度が得られ、ホスト材料としても機能することが分か10った。

58

【0119】 【化44】 化合物C

【0120】同様に、本発明の他の化合物を含有するE L素子を作製・評価したところ、本発明の化合物がEL 素子材料(電荷輸送材料・発光材料・ホスト材料)とし て機能することが確認できた。特に、色純度の高い青色 あるいは緑色の発光素子を作製できることが分かった。 【0121】

【発明の効果】本発明の化合物は有機EL用材料として使用可能であり、本発明の化合物を含有する素子は色相・輝度などのEL特性に優れる。また、本発明の化合物30 は医療用途、蛍光増白剤、写真用材料、UV吸収材料、レーザー色素、カラーフィルター用染料、色変換フィルター等にも適用可能である。

# フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	· FI	テーマコード(参	考)
C O 7 D 231/12		C O 7 D 231/12	Α	
235/18		235/18		
241/12		241/12	•	
249/08	513	249/08	513	
263/56		263/56		
271/06		271/06	•	
271/10		271/10		
<b>277/66</b>		277/66		
285/125		487/04	139	•

(31)

特開2000-355687

487/04 CO7F 3/06

139

CO7F 3/06 CO7D 285/12

**D** .